

D1FH3

30V 3A

特長

- 小型SMD
- 極超低VF=0.36V

Feature

- Small SMD
- Super-Low VF=0.36V

用途

- パンアリ 逆接防止
- DC/DCコンバータ
- 携帯電話、パソコン
- Reverse connect protection for DC power source
- DC/DC Convertor
- Mobile phone, PC

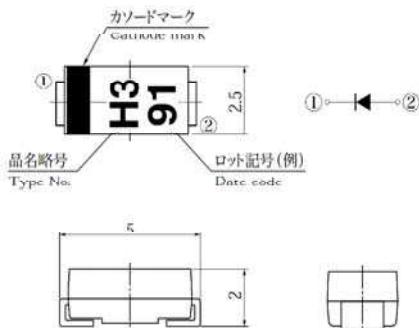
Main Use

■外観図 OUTLINE

Package : 1F

Unit:mm

Weight 0.058g(Typ)



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示について、は捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tc = 25°C)

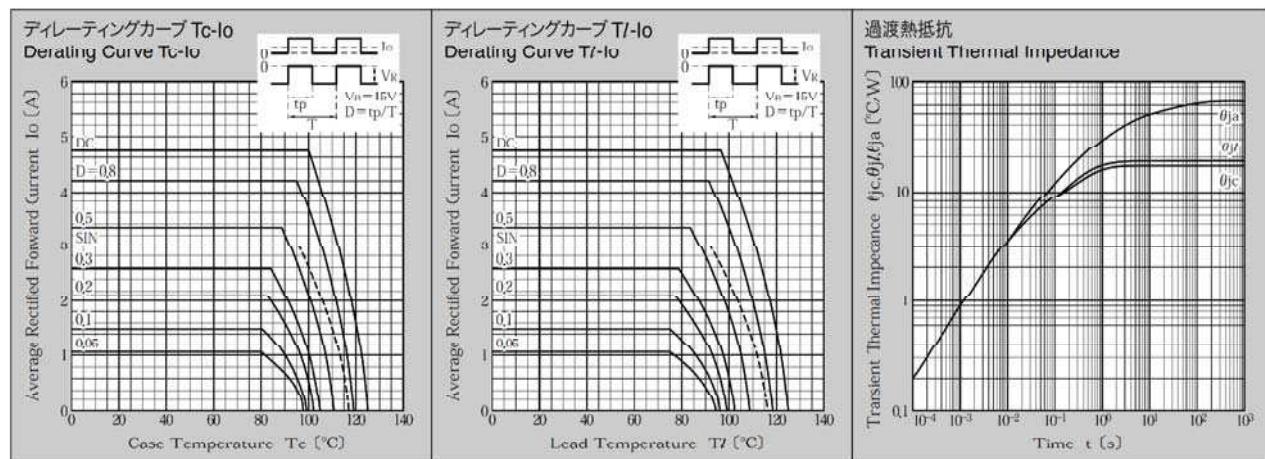
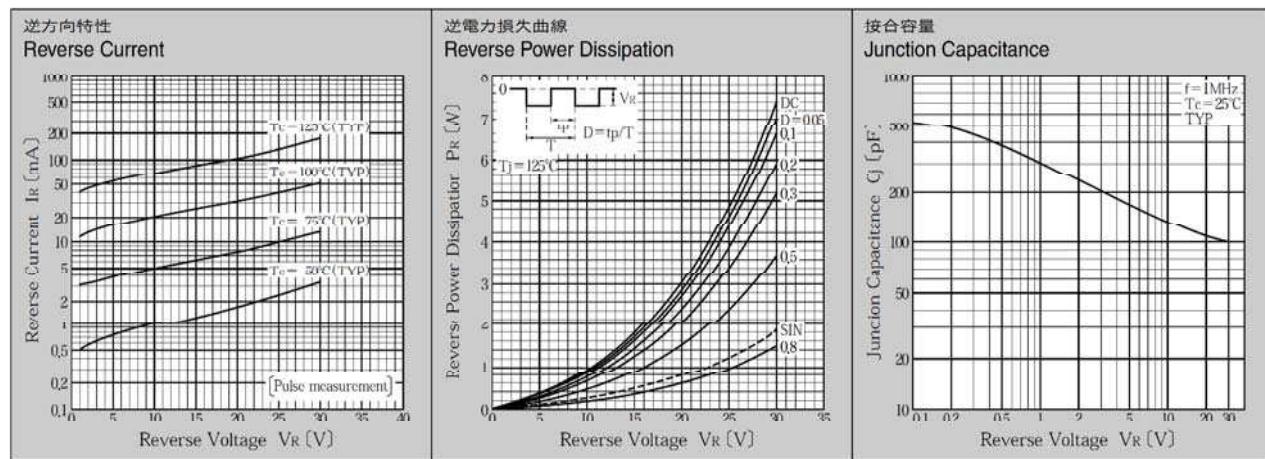
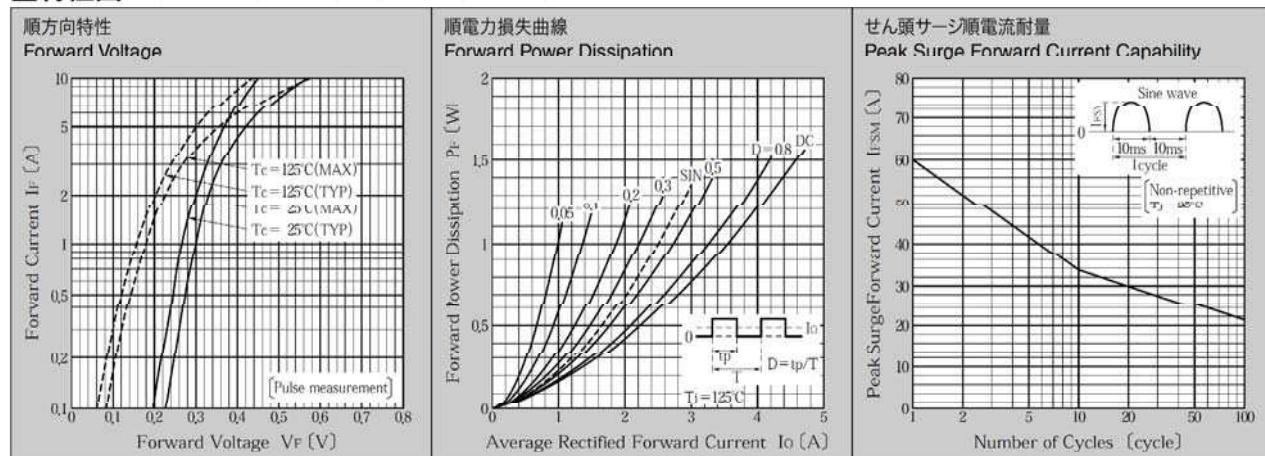
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D1FH3	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55 ~ 125	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			125	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			30	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, Tc = 95°C 50Hz sine wave, Resistance load, Tc = 95°C		3.0	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj = 25°C		60	A

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tc = 25°C)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 1.0A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.30	V
		I _F = 3.0A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.36	
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} , パルス測定 Pulse measurement	MAX 2.0	mA
接合容量 Junction Capacitance	C _J	f = 1MHz, V _R = 10V	TYP 130	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{JC}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 16	°C/W
	θ _{JL}	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 18	
	θ _{JA}	接合部・周囲間, プリント基板実装 Junction to ambient, On glass epoxy substrate	MAX 65	

Small SMD

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
 Typicalは統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.